

温度补偿晶体振荡器

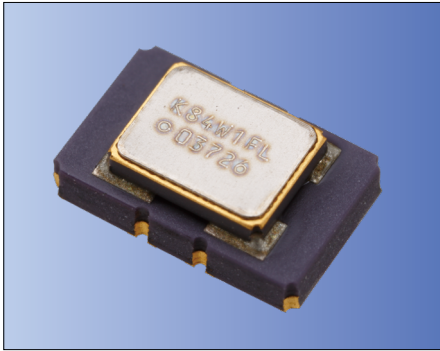
Temperature Compensated Crystal Oscillators (TCXO, VCTCXO)

点击此处搜索TCXO



表面贴装型TCXO KT5032F系列 (Smallcell/ Stratum3用)

5.0×3.2mm



RoHS指令对应产品

■特点

- 高精度，高可靠性
- 电源电压：可对应2.3~3.63V
- 可选择削峰正弦波/CMOS输出
- 低相噪产品
- 工作温度：-40~+105°C (可选)

■用途

- 5G、Smallcell、Stratum3
- SONET/ SDH/ Ethernet
- SyncE/ IEEE 1588

■型号表示方法

KT5032F 20000 33 T XX
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

①系列名称

③振荡频率稳定度

U	$\pm 0.5 \times 10^{-6}$
K	$\pm 0.28 \times 10^{-6}$
A	$\pm 0.1 \times 10^{-6}$

②输出频率

④工作温度范围

GT	-10°C ~70°C
AW	-40°C ~85°C
AY	-40°C ~105°C

⑤电源电压

33	3.3V
----	------

⑥电压控制功能

T	无电压控制
规格代号*	带电压控制

* 如需带电压控制，敬请咨询。

⑦个别规格

包装方式(载带包装 1000个/卷盘)

■规格

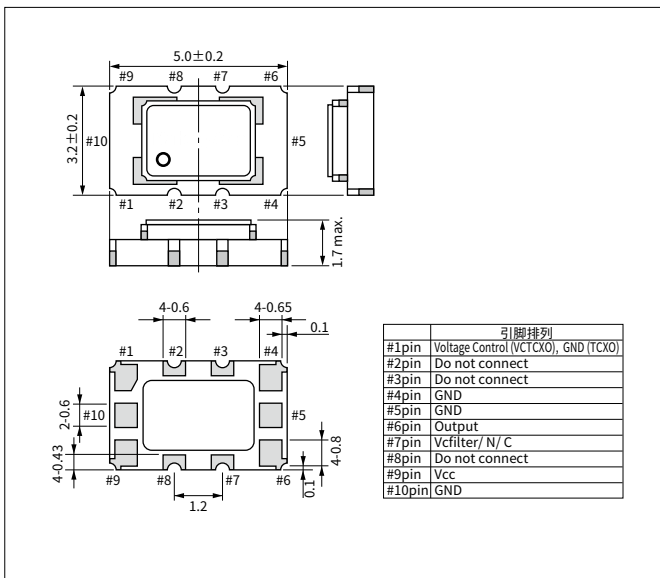
项 目	记 号	条 件	规 格		单 位	
			Min.	Max.		
输出频率范围	fo	标准输出频率: 10 / 12.8 / 20 / 25.6 / 44.8	10	44.8	MHz	
频率容差	f _{tol}	vs 温度 [±(f _{max} -f _{min})/2fo]	-0.5	+0.5	×10 ⁻⁶	
		vs 电源电压	-0.28	+0.28		
			-0.1	+0.1		
电源电压	V _{cc}		+2.3	+3.63	V	
电流消耗	I _{cc}	CMOS Output	—	6	mA	
频率老化特性	f _{age}	20years@40°C. 温度特性、起始偏差、电源电压变化、含负载变动	-4.6	+4.6	×10 ⁻⁶	
电压控制范围	f _{cont}	正方向(positive)※输入阻抗 100k ohm min	±5	±20	×10 ⁻⁶	
输出电压	V _{pp}	Clipped Sine*、负载10k ohm // 10pF	0.8	—	Vp-p	
L电平输出电压	VoL	CMOS、负载15pF (I _{oL} =4mA)	—	10% V _{cc}	V	
H电平输出电压	VoH	CMOS、负载15pF (I _{oH} =-4mA)	90% V _{cc}	—	V	
上升/下降 (10% V _{cc} ~90% V _{cc})	Tr/ Tf	CMOS、负载15pF	—	8	ns	
波形对称	SYM	50% V _{cc}	45	55	%	
Phase Noise	—	@20MHz	@10Hz offset	—	-90	dBc/ Hz
			@100Hz offset	—	-120	
			@1kHz offset	—	-140	
			@10kHz offset	—	-150	
			@100kHz offset	—	-150	

* 本产品没有内置直流切割用电容器。削峰正弦输出时，请在振荡器输出线路上连接直流切割用电容器(1nF以上)后使用。

* 格为标准产品规格，有关其他要求规格，敬请咨询。

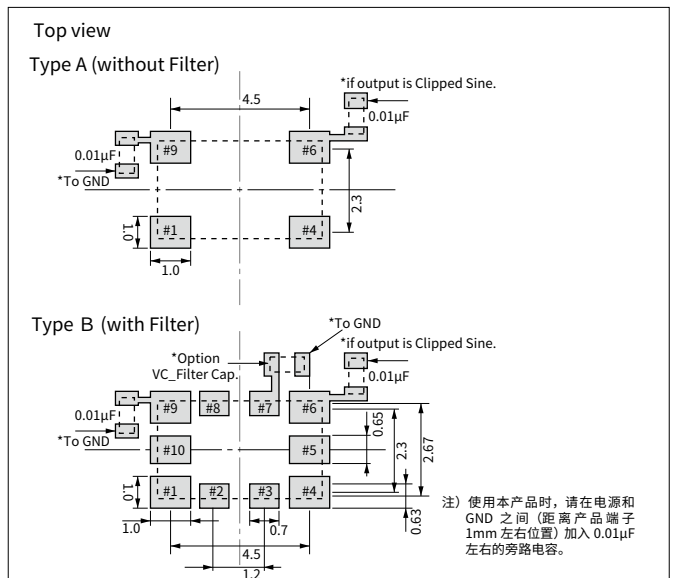
■外形尺寸

(单位: mm)



■推荐焊盘图案

(单位: mm)



温度补偿晶体振荡器